Metropolia ammattikorkeakoulu Elektroniikan koulutusohjelma

Pasi Karjalainen

2,45 GHz:n mikroliuska-antennin suunnittelu ja toteutus Zigbee-sovellukseen

> Insinöörityö 13.5.2009 Työn ohjaaja: yliopettaja Heikki Valmu Työn valvoja: yliopettaja Heikki Valmu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinöörityön tiivistelmä

Tekijä	Pasi Karjalainen
Otsikko	2,45GHz:n mikroliuska-antenni suunnittelu ja toteutus Zigbee-sovellukseen
Sivumäärä	56 sivua
Aika	13.5.2009
Koulutusohjelma	elektroniikka
Tutkinto	insinööri (AMK)
Ohjaaja	yliopettaja Heikki Valmu
Ohjaava opettaja	yliopettaja Heikki Valmu

Tämän insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa 2,45 GHz:n antenni. Antenni suunniteltiin anturikeskuksen Zigbee-projektia varten. Zigbee on IEEE 802.15.4 –standardin mukainen tiedonsiirto tekniikka. Zigbee-projekti on Metropolia ammattikorkeakoulun ja anturikeskuksen yhteinen projekti, jossa on mukana kahdeksan opiskelijaa. Tämän insinöörityön tavoite oli suunnitella projektia varten antenni.

Antenni päätettiin toteuttaa mikroliuska-antennina. Mikroliuska valittiin sen ominaisuuksien, kuten pienen koon ja keveyden takia. Mikroliuska-antennista tehtiin ympäripolarisoitu antenni. Antenni suunniteltiin toimimaan 2,45 GHz:n resonanssitaajuudella.

2,45 GHz:n resonanssitaajuutta ei saavutettu riittävällä tarkkuudella eikä myöskään 80 MHz:n kaistanleveyttä. Antenni sovitus puolestaan saatiin lähelle tavoiteltua 50 ohmin sovitusta. Päätettiin kuitenkin tehdä protoantenni ja jatkaa tuotekehitystä.

Hakusanat	antenni, mikroliuska, mikroliuska-antenni

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Abstract

Author	Pasi Karjalainen
Title	The design and implementation of 2.45 GHz microstrip antenna for Zigbee -application
Pages	56 pages
Date	13 May 2009
Degree Programme	Electronics Engineering
Degree	Bachelor of Engineering
Instructor	Heikki Valmu, Principal Lecturer
Supervisor	Heikki Valmu, Principal Lecturer

The purpose of this final year thesis was to design a 2.45 GHz antenna. The antenna was designed for the sensor centre's Zigbee -project. Zigbee is based on the IEEE 802.15.4 –standard and is a wireless data transmission technique. Zigbee –project is a joint project of the sensor centre and Metropolia University of Applied Sciences. There were 8 students in the project. The purpose of this final year project was to design an antenna for the project.

The antenna was implemented into a microstrip antenna. The microstrip was selected because of its characteristics, such as small size and light weight. The microstrip antenna was implemented into a dual polarized antenna. The antenna was designed to run at 2.45 GHz.

The 2.45 GHz resonant frequency was not achieved at an adequate accuracy nor the bandwidth of 80 MHz. The impedance of antenna was matched to near 50 ohms. However, a decision was made to build the proto antenna and continue the product development

Keywords	antenna, microstrip, microstrip antenna

Sisällys

Tiivistelmä		2
Abstract		3
Sisällys		4
Symboliluett	elo	6
Lyhenteet, k	äsitteet ja määritelmät	8
1 Johdanto		10
2 Radioaallo	t	11
	2.1 Radioaaltojen taajuusalueet	12
3 Mikroliusk	a	13
	3.1 Mikroliuskajohdon mitoitus3.2 Mikroliuskajohdon dispersio3.3 Avoin johdonpää	13 16 17
4 Antennit		20
	 4.1 Antennien peruskäsitteitä 4.1.1 Resiprookkisuus 4.1.2 Kentät 4.1.3 Säteilykuvio 4.1.4 Vahvistus 4.1.5 Suuntaavuus 4.1.6 Polarisaatio 4.1.7 Impedanssi, hyötysuhde ja kaistanleveys 	20 20 20 22 23 24 25 27
5 Zigbee		29
	5.1 Protokollapino5.2 Tekniikka yleisesti5.3 Taajuusalue ja modulaatio5.4 Siirtonopeus ja –matka	29 30 31 31
6 Mikroliusk	ca-antenni	32
	6.1 Syöttötekniikat6.2 Suorakulmainen mikroliuska-antenni koaksiaalisyötöllä	32 33

	6.3 Ympyräpolarisaatio	36
	6.4 Hyötysuhde ja kaistanleveys	37
7 Antenr	nin suunnittelu ja mittaus	39
	7 1 Antennin suunnittelu	30
	7.1.1 Antennin mitoitus	39
	7.2. Antennin valmistus	42
	7.3 Mittaukset	46
	7.3.1 Piirianalysaattorin kalibrointi	46
	7.3.2 Antennin mittaus	48
8 Vhteer	nveto.	52
0 1 11001		52
Lähteet		53
Liitteet		55
T'' 1 (
Liite I: S	Siirtovanvistuksen mittaus 1	22
Liite 2: S	Siirtovahvistuksen mittaus 2	56
		50

Symboliluettelo

В	suskeptanssi
D	antennin suurin mitta säteilysuuntaa vastaan kohtisuorassa tasossa
D	suuntaavuus
dBd	antenninvahvistus ideaaliseen puoliaaltodipoliin verrattuna
dBi	antenninvahvistus isotrooppiseen säteilijään verrattuna
c	valonnopeus tyhjiössä, n. 2,998×10 ⁸ m/s
C_0	päätykapasitanssi
d	etäisyys
f	taajuus
f _r	resonanssitaajuus
G	vahvistus paljaana lukuna
G dB	vahvistus desibeleinä
Gr	säteilykonduktanssi
h	korkeus
Hz	hertsiä, taajuuden yksikkö
j	imaginääriosa
k ₀	aaltoluku, $2\pi/\lambda$
L	levyn pituus
1	pituus
$\lambda_{ m o}$	aallonpituus tyhjiössä
$\lambda_{_g}$	aallonpituusmateriaalissa
P_{c}	johdehäviöt
Q	hyvyysluku
Q_c	johdinhäviöiden hyvyysluku
Q_{d}	dielektristen häviöiden hyvyysluku
Q_r	säteilyhyvyysluku
Q_t	kokonaishyvyyslyku

r	etäisyys
R _e	kahden levyn välisen aukon säteilyresistanssi
R_r	säteilyhäviöt
R_h	ohmiset häviöt
S	tehotiheys
<i>S</i> ₀	häviöttömän isotrooppisen antennin säteilemä tehotiheys
t	paksuus
W	leveys
W_T	kokonaisenergia
x	etäisyys levyn keskipisteestä
Z_a	antennin impedanssi
Z_0	ominaisimpedanssi
Z_{in}	sisäänmenoimpedanssi
π	pii, n. 3,1415
Ω	ohmia, vastusarvo
$\Omega_{_A}$	avaruuskulma
\mathcal{E}_r	suhteellinen permittiivisyys, dielektrisyysvakio
${\cal E}_{\it reff}$	tehollinen permittiivisyys
${oldsymbol \eta}_p$	tehohyötysuhde
η_r	säteilyhyötysuhde
Δl_0	avoimen pään pidennys mikroliuskajohdossa
ω_r	kulmaresonanssitaajuus
δ_{s}	tunkeutumissyvyys

Lyhenteet, käsitteet ja määritelmät

BPSK	Binary Phase Shift Keying, binaarinen vaiheavainnus				
Dielektrinen	Ei-sähköinen, eriste				
FFD	Full Functon Device, täyden toiminnan laite				
FR4	Flame Retardant 4, piirilevyjen tekoon käytetty materiaali				
ISM	Industrial, Scientific & Medical, tarkoitettu teolliseen, tieteelliseen ja lääketieteelliseen käyttöön				
IEEE 802.15.4	Standardi, joka määrittelee lyhyen kantaman tietoliikenneverkkoa				
ITU	International Telecommunication Union, kansainvälinen televiestintäliitto				
MAC	Media Access Control, IEEE 802-verkoissa verkon varaamisen ja itse liikennöinnin hoitava osajärjestelmä				
NCN	Network Coordinator Node, verkon koordinaattori				
O-QPSK	Orthogonal Quadrature Phase Shift Keying, ortogonaalista nelivaiheista vaiheavainnusta				
PAN	Personal Area Network, henkilökohtainen verkko				
Prototyyppi	Testausta varten valmistettu kokonainen sovellus tai sovelluksen osa				

RFD	Reduced Function Device, rajoitetun toiminnan laite
SMA-liitin	Pienikokoinen kierrekiristeinen liitin, taajuus aina 18 GHz:iin asti
TEM	Transverse electric and magnetic, sähkömagneettisen kentän etenemismuoto, jossa sekä sähkö- että magneettikenttä ovat liikettä vastaan kohtisuorassa
UV	Ultraviolettisäteily

1 Johdanto

Tämän insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kahden polarisaation mikroliuska-antenni, jonka resonanssitaajuus on 2,45 GHz. Anteeni oli tarkoitus liittää anturikeskuksen Zigbee-sovellukseen.

Anturikeskus sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman tuntumassa olevan Electrian tiloissa. Electria on vuonna 2004 toimintansa aloittanut elektroniikka-alan valmistus-, tutkimus- ja koulutuspalveluita tarjoava yksikkö ja se on osa Metropolia-Ammattikorkeakoulua.

Metropolialla on anturikeskuksen kanssa yhteinen Zigbee-projekti. Projektissa on mukana kahdeksan insinöörityön tekijää, jotka kehittävät osaamista eri osa alueilla. Tässä insinöörityössä on tarkoitus kehittää parempi antenni Zigbee-sovellukseen.

Metropolian elektroniikan koulutusohjelmassa on alettu keskittää opetusta langattomiin järjestelmiin. Opetuksessa on lisätty sulautettujen järjestelmien ja erilaisten tunniste- ja anturiteknologioiden opetusta. /1/

2 Radioaallot

Radioaallot ovat sähkömagneettisia aaltoja, joilla on aallonpituus, etenemisnopeus, polarisaatio ja taajuus. Sähkömagneettinen aalto muodostuu sähkö- ja magneettikentästä, jotka ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan ja kohtisuorassa myös aallon etenemissuuntaan nähden. Sähkö- ja magneettikentän voimakkuudet vaihtelevat ajan ja paikan suhteen sinimuotoisesti. Kentän suurin arvo eli aallon huipun korkeus on kentän amplitudi, ja aallon huippujen välinen etäisyys on aallonpituus, joka voidaan laskea yhtälöstä:

$$\lambda = \frac{c}{f},\tag{2.1}$$

jossa valonnopeus c = 2,998 $\times 10^8$ m/s ja f on taajuus (Hz). Aallon pituus materiaalissa saadaan yhtälöstä:

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\mathcal{E}_{reff}}},\tag{2.2}$$

jossa λ_0 on aallonpituus tyhjiössä ja ε_{reff} on efektiivinen permittiivisyys yhtälöstä (3.1) tai (3.3). /2, s. 58-60/



Kuva 1. Sähkömagneettisen aallon sähkökentän ja magneettikentän suuruuksien vaihtelu etenemissuuntaisella akselilla. /2, s.59/

2.1 Radioaaltojen taajuusalueet

Radioaaltojen taajuusalue käsittää 3 kHz - 300 GHz:n taajuudet, ja ne jaetaan eri alueisiin käyttötarkoituksen mukaan, kuten kuvasta 2 nähdään. Käyttösuunnitelma perustuu kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n (International Telecommunication Union) päätöksiin. Tarkemmin tässä sovelluksessa käytetään mikroaaltoja, joiden taajuudet ovat 1- 30 GHz. Aallot eivät ole kuitenkaan mikrometrin pituisia, kuten nimestä voisi päätellä. /3, s. 68-71/



Kuva 2. Radiotaajuuksien käyttökohteita ja taajuusalueet /3, s.70/

3 Mikroliuska

Mikroliuska on planaarinen eli tasomainen aaltojohto. Se muodostuu liuskajohtimesta ja maatasosta, joiden välillä on dielektrinen levy eli substraatti kuvan 3 mukaisesti. Substraatin paksuus h ja johtimen paksuus t ovat materiaalikohtaisia. Liuskajohtimen leveys w voidaan määritellä laskemalla. Eristeaineena oleva substraatti toimii mekaanisesti johtimen tukena, ja vaikuttaa myös sähköisiin ominaisuuksiin. Sähkökenttä on osittain ilmassa ja osittain substraatissa. Tällöin kenttä on lähes kokonaan johdon poikkitasossa, sillä on myös etenemissuuntaiset komponentit. Tästä syntyvää aaltomuotoa kutsutaan kvasi-TEM-aalloksi. /3, s. 15-21/



Kuva 3. Mikroliuskajohto /3, s.17/

3.1 Mikroliuskajohdon mitoitus

Mikroliuskajohdon kentät ja sähköiset ominaisuudet voidaan laskea erilaisin numeerisin menetelmin. Seuraavat likimääräiset yhtälöt pätevät, kun $0,05 \le w/h \le 20$ ja suhteellinen permittiivisyys $\mathcal{E}_r \le 16$. Yhtälöt perustuvat oletukseen, että aalto etenee kvasi-TEM-muodossa. Kun w/h \leq 1, saadaan efektiivinen permittiivisyys ε_{reff} ja ominaisimpedanssi Z_0 yhtalöistä:

$$\varepsilon_{reff} \approx \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{1 + 12h/w}} + 0.04 \left(1 - \frac{w}{h} \right)^2 \right]$$
(3.1)

$$Z_{0} \approx \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_{reff}}} \ln\left(\frac{8h}{w} + \frac{w}{4h}\right) \Omega$$
(3.2)

Kun w/h≥1, yhtälöstä:

$$\varepsilon_{reff} \approx \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + 12h/w}}$$
(3.3)

$$Z_{0} \approx \frac{120}{\sqrt{\varepsilon_{reff}} \left[w/h + 1,393 + 0,667 \ln(w/h + 1,444) \right]} \Omega.$$
(3.4)

Suurimmillaan efektiivisen permittiivisyyden ε_{reff} virhe on ± 0,5 % ja ominaisimpedanssin $Z_0 \pm 0,8$ %. Kun tunnetaan suhteellinen permittiivisyys ε_r ja ominaisimpedanssi Z_0 , voidaan laskea w/h yhtälöistä:

 $w/h \leq 2$:

$$\frac{w}{h} \approx \frac{8e^A}{e^{2A} - 2}.$$
(3.5)

 $w/h \ge 2$:

$$\frac{w}{h} \approx \frac{2}{\pi} \left\{ B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\varepsilon_r - 1}{2\varepsilon_r} [\ln(B - 1) + 0.39 - \frac{0.61}{\varepsilon_r}] \right\}.$$
(3.6)

Apusuureet A ja B saadaan yhtälöistä:

$$A = \frac{Z_0}{60} \sqrt{\frac{\varepsilon_r + 1}{2}} + \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 1} \left(0,23 + \frac{0,11}{\varepsilon_r} \right)$$
(3.7)

$$B = \frac{377\pi}{2Z_0\sqrt{\varepsilon_r}}.$$
(3.8)

Yhtälöt (3.1) - (3.6) pätevät, kun liuskan paksuus t on 0. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole. Liuskan tehollinen leveys w_{eff} saadaan yhtälöstä:

$$w_{eff} = w + t \frac{1 + \frac{1}{\varepsilon_r}}{2\pi} \ln \left(\frac{4e}{\sqrt{\left(\frac{t}{h}\right)^2 + \left(\frac{1}{\pi} \frac{1}{\frac{w}{t} + \frac{11}{10}}\right)^2}} \right),$$
(3.9)

jossa w on antennin leveys, t metalliliuskan paksuus, h substraatin paksuus ja ε_r suhteellinen permittiivisyys. Mikroliuskajohtoa mitoitettaessa voidaan myös käyttää valmiita käyrästöjä, kuten kuvassa 4 on esitetty. /3, s. 15-21/



Kuva 4. Mikroliuskajohdon mitoitukseen tarkoitettu käyrästö, jossa ominaisimpedanssi Z_0 w/h:n funktiona eri eristeaineiden tapauksessa. /3, s.18/

3.2 Mikroliuskajohdon dispersio

Yli muutaman GHz:n taajuuksilla johdossa etenevä aalto ei muistuta enää kvasi-TEMaaltoa, vaan aalto etenee hybridimuodolla. Tällöin sähkö- ja magneettikentän pitkittäiskomponentit ovat merkittäviä, joten dispersio on otettava huomioon. Taajuuden kasvaessa kentät keskittyvät yhä enemmän substraattiin. Näin ollen $\varepsilon_{reff}(f)$ kasvaa ja lähestyy ε_r :ää, kuten kuvasta 5 nähdään. /3, s. 15-21/



Kuva 5. Mikroliuskajohdon dispersio /3, s.20/

Mikroliuskajohdon dispersiolle on esitetty monia yhtälöitä. Tehollinen permittiivisyys taajuuden funktiona saadaan yhtälöstä:

$$\varepsilon_{reff}(f) = \varepsilon_r - \frac{\varepsilon_r - \varepsilon_{reff}}{1 - G(f/f_p)^2},$$
(3.10)

jossa $f_p = Z_0 / (8\mu_0 h)$ ja G on empiirinen kerroin. Dispersion vaikutuksesta myös ominaisimpedanssi ja tehollinen leveys muuttuvat. Ominaisimpedanssi saadaan yhtälöstä:

$$Z_0(f) = \frac{h\eta_0}{w_{eff}(f)\sqrt{\varepsilon_{reff}(f)}},\tag{3.11}$$

jossa $\eta_0 = 120\pi\Omega$ on tyhjiön aaltoimpedanssi. Tehollinen leveys saadaan yhtälöstä:

$$w_{eff}(f) = w + \frac{w_{eff} - w}{1 + (f/f_p)^2},$$
(3.12)

jossa $f_p = c / (2w_{eff} \sqrt{\varepsilon_{reff}(f)})$ ja w_{eff} on tehollinen leveys taajuudella 0. /3, s. 15-21/

3.3 Avoin johdonpää

Mikroliuskajohdon epäjatkuvuutta käytetään hyväksi halutessa piiriltä erityisiä ominaisuuksia. Avointa mikroliuskajohdon päätä käytetään resonaattorina. Ideaalisessa tapauksessa avoimen pään resistanssi on ääretön. Avoimessa päässä sähkökenttä ulottuu johdon pään yli, kuten kuvasta 6 nähdään. /3, s. 29-31/



Kuva 6. Avoin mikroliuskajohdon pää /3, s.30/

Avoin pää voidaan mallintaa johdon geometrisessä päädyssä olevalla kapasitanssilla tai johdon pidennyksellä, jonka päässä on ideaalinen avoin pää. Johdon pidennys saadaan laskettua yhtälöstä:

$$\frac{\Delta l_0}{h} = ACE/D \tag{3.13}$$

Apusuureet A, C, E ja D saadaan seuraavista yhtälöistä:

$$A = 0,434907 \frac{(\mathcal{E}_{reff}^{0.81} + 0,26)[(w/h)^{0.8544} + 0,236]}{(\mathcal{E}_{reff}^{0.81} - 0,189)[(w/h)^{0.8544} + 0,87]},$$
(3.14)

$$B = 1 + \frac{(w/h)^{0.371}}{2,358\varepsilon_r + 1},$$
(3.15)

$$C = 1 + \frac{0.5274 \arctan[0.084(w/h)^{1.9413/B}]}{\varepsilon_{reff}},$$
(3.16)

$$D = 1 + 0.0377 \arctan[0.067(w/h)^{1.456}][6 - 5e^{0.036(1-\varepsilon_r)}] \text{ ja}$$
(3.17)

$$E = 1 - 0.218e^{-7.5w/h}$$
(3.18)

Yhtälön tarkkuus on 0,2%, kun 0,01 $\leq w/h \leq 100$ ja 1 $\leq \varepsilon_r \leq 128$ (ehtona t = 0). Yhtälö pätee matalilla taajuuksilla. Päätykapasitanssi C_0 saadaan yhtälöstä:

$$C_0 = \frac{\Delta l_0 \sqrt{\varepsilon_{reff}}}{c_0 Z_0}. \ /3, \ \text{s. 29-31/}$$
(3.19)

4 Antennit

Antenni on laite, jolla voidaan lähettää ja vastaanottaa kontrolloidusti sähkömagneettisia aaltoja. Antennien rakenne vaihtelee käyttötaajuudesta ja tarkoituksesta riippuen. Esimerkiksi tässä projektissa päädyttiin mikroliuska-antenniin sen pienen koon ja helpon toteutuksen vuoksi.

4.1 Antennien peruskäsitteitä

Antenneilla on monia peruskäsitteitä, jotka voidaan määritellä kaikille antenneille niiden rakenteesta riippumatta. Seuraavaksi on esitelty antenneille oleellisia peruskäsitteitä.

4.1.1 Resiprookkisuus

Antennit ovat resiprookkisia, eli antennin ominaisuudet ovat samat lähetyksessä ja vastaanotossa. Resiprookkisuus ei kuitenkaan päde, jos antennissa on epäresiprookkisia komponentteja, kuten vahvistimia ja ferriittikomponentteja. /4/

4.1.2 Kentät

Antennin ympärilleen synnyttämä sähkömagneettinen kenttä voidaan jakaa kolmeen osaan: reaktiivisen lähikenttään, säteilevään lähikenttään (Fresnelin alue) ja kaukokenttään (Fraunhoferin alue) kuvan 7 mukaisesti. Jako tapahtuu kentän ominaisuuksien perusteella. Tarkat rajat ovat keinotekoisia, koska muutokset kentässä tapahtuvat vähitellen. /4/ /5, s. 23-25/



Kuva 7. Antennin lähi- ja kaukokenttä /5, s.24/

Lähimpänä antennia on reaktiivinen lähikenttä. Reaktiivisessa lähikentässä reaktiivinen osa on vallitseva. Reaktiivisen ja säteilevän lähikentän arvioitu raja määritellään seuraavan yhtälön mukaisesti:

$$r = \frac{\lambda}{2\pi},\tag{4.1}$$

jossa r on etäisyys säteilylähteestä ja λ säteilevän signaalin aallonpituus. Reaktiivinen osa pienenee nopeasti etäisyyden kasvaessa $(1/r^2 \tan 1/r^3)$ ja on merkityksetön säteilevän lähikentän eli Fresnelin alueella. Fresnelin alueella sähkö- ja magneettikentät eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan kuten kaukokentässä. Siksi sähkökentän komponenteista ei voi päätellä magneettikenttää eikä päinvastoin. /4/

Kaukokentässä ominaisuudet eivät ole riippuvaisia etäisyydestä, paitsi kentän voimakkuuteen etäisyydellä on vaikutusta. Kenttä pienenee kääntäen verrannollisesti etäisyyteen. Kaukokentän raja saadaan yhtälöstä:

$$r = \frac{2D^2}{\lambda},\tag{4.2}$$

jossa D on antennin suurin mitta säteilysuuntaa vastaan kohtisuorassa tasossa ja λ säteilevän signaalin aallonpituus. /4/

4.1.3 Säteilykuvio

Lähettävän antenni säteilykuviosta (tai suuntakuviosta) nähdään, miten antennin lähettämä signaaliteho jakautuu avaruuteen. Vastaanottoantennin suuntakuvio puolestaan kuvaa, miten hyvin antenni vastaanottaa eri suunnista tulevaa sähkömagneettista säteilyä.

Yleensä antennit säteilevät voimakkaasti johonkin tiettyyn suuntaan. Tällöin suuntakuviossa on selkeä pääkeila ja tämän lisäksi heikompia maksimeja eli sivumaksimeja, kuten kuvasta 8 nähdään. Suuntakuviossa on myös nollakohtia, joiden suuntaan antenni ei säteile lainkaan ja joista se ei vastaanota mitään. Antennin suuntakuvio ilmoittaa suhteellisen kentänvoimakkuuden suunnan funktiona, ja yleensä se normalisoidaan niin, että maksimiarvoksi annetaan 1 eli 0 dB (Kuva 8). /4/



Kuva 8. Suorakulmainen esitysmuoto /4, s.159/

Suuntakuviolla on monenlaisia esitysmuotoja. Suuntaaville antenneille sopii suorakulmaisnen esitysmuoto (kuva 8), ympärisäteilevälle antenneille sopii polaarinen esitys (kuva 9). Antennin täydellinen säteilykuvio voidaan esittää kolmiulotteisesti tai vakiokäyrinä (kuva 10).



Kuva 9. Polarisaatioesitys /4, s.159/



Kuva 10. Kolmiulotteisena ja vakiokäyrästönä esitetyt säteilykuviot /4, s.159/

4.1.4 Vahvistus

Antennin vahvistus on pääkeilan suuntaan säteilemän tehotiheyden S suhde häviöttömän isotrooppisen antennin säteilemään tehotiheyteen S_0 , kun molempiin antenneihin syötetään sama lähtöteho. Vahvistus saadaan yhtälöstä:

$$G = \frac{S}{S_0}.$$
(4.3)

Vahvistus ilmoitetaan yleensä desibeleinä:

$$G_{db} = 10\log G. \tag{4.4}$$

Edellä olevat yhtälöt pätevät ideaaliselle eli häviöttömälle antennille. Käytännössä osa tehosta kuluu kuitenkin metallipintojen tai dielektristen aineiden häviöihin. Nämä häviöt pienentävät vahvistusta, ja näin ollen vahvistus on suuntaavuutta pienempi. Häviöllisten antennien vahvistus saadaan yhtälöstä:

$$G = \eta \frac{S}{S_0},\tag{4.5}$$

jossa η on säteilyhäviösuhde. /4/

Antennivahvistus ilmoitetaan joko isotrooppiseen säteilijään dBi tai ideaaliseen puoliaaltodipoliin dBd verrattuna. Isotrooppiseen säteilijään suhteutetut vahvistusarvot ovat 2.15 dB suurempia kuin puoliaaltodipolin. /4/

4.1.5 Suuntaavuus

Suuntaavuus kuvaa antennin kykyä keskittää säteilyä tiettyyn suuntaan. Suuntaavuus D saadaan koko avaruuskulman 4π yli lasketun suuntakuvion $P(\theta, \phi)$ integraalin avulla:

$$D = \frac{4\pi}{\int \int_{4\pi} P_n(\theta, \phi) d\Omega},$$
(4.6)

jossa $d\Omega$ on avaruuskulman alkio. Keilan avaruuskulma Ω_A saadaan lasketuksi yhtälöstä:

$$\Omega_A = \int \left| P(\theta, \phi) \right|^2 d\Omega.$$
(4.7)

Suuntaavuus on pelkästään riippuvainen säteilykuviosta. Suuntaavuus esitetään yleensä yhtenä lukuna eikä kulmien funktiona. Tällöin kyseessä on suuntaavuuden maksimiarvo, joka saadaan seuraavasta yhtälöstä:

$$D = \frac{4\pi}{\Omega_A}.$$
(4.8)

Suuntaavuus voidaan laskea myös etäisyyden suhteen, joka saadaan seuraavasta yhtälöstä:

$$D = 4\pi r^2 \frac{S}{S_0},$$
 (4.9)

jossa r on etäisyys metreinä. /4/

4.1.6 Polarisaatio

Antennin polarisaatio kuvaa sen säteilemän sähkökentän kompleksisen vektorin suunnan muutoksia. Polarisaatio ei ole riippuvainen vektorin amplitudista tai vaiheesta. Kompleksinen vektori määrittelee ellipsin, jonka voidaan ajatella piirtyvän vektorin kärjestä värähtelyjakson aikana (kuva 11). /5, s. 30-37/



Kuva 11. Elliptinen polarisaatio /4, s.160/

Erikoistapauksessa ellipsistä muodostuu jana (kuva 12) tai ympyrä (kuva 13). Janaa kutsutaan lineaariseksi polarisaatioksi ja ympyrää ympyräpolarisaatioksi. Lineaarinen polarisaatio voi olla horisontaalista tai vertikaalista ja ympyräpolarisaatio on oikea- tai vasenkätistä. /5, s. 30-37/



Kuva 12. Vertikaalinen ja horisontaalinen polarisaatio /6/



Kuva 13. Oikea- ja vasenkätinen ympyräpolarisaatio /6/

Yleensä antenni on tarkoitettu toimimaan jollain tietyllä polarisaatiolla. Tätä polarisaatiota kutsutaan pääpolarisaatioksi. Tuleva aalto sovittuu hyvin antenniin, jos aallon polarisaatio on sama kuin antennin polarisaatio. Jos puolestaan polarisaatio eroaa, syntyy epäsovitusta. Tämä laskee antennin polarisaatiohyötysuhdetta. /5, s. 30-37/

4.1.7 Impedanssi, hyötysuhde ja kaistanleveys

Antenneille pätee yleiset piiriominaisuudet. Syöttönavoista katsottaessa antenni näkyy impedanssina $Z_a = R_a + jX_a$ (kuva 14). Impedanssin resistiivinen osa R_a muodostuu antennin säteilyhäviöiden R_r ja antenninrakenteen ohmisten häviöiden R_h summasta. Imaginäärinen osa X_a on antennin lähikenttään varastoitunut energia. Antennin ollessa resonanssissa reaktiivinen osa X_a häviää. /5, s. 30-37/



Kuva 14. Antennin vastinpiiri /5, s.36/

Antennin hyötysuhde kuvaa sen tehohyötysuhdetta. Hyötysuhde on riippuvainen säteilyhäviöiden R_r ja antenninrakenteen ohmisista häviöistä R_h . Säteilyhäviöt johtuvat antennin ja aaltojohdon epäsovituksesta. Erisuuruiset impedanssit aiheuttavat rajapinnassa heijastumisia, jotka havaitaan signaalitehon heikentymisenä sekä häiriöinä. Heijastukset tapahtuvat herkemmin suurilla kuin pienillä taajuuksilla. Ohmiset häviöt ovat puolestaan riippuvaisia antennin metalli- tai dielektrisistä häviöistä. Antennille voidaan laskea tehohyötysuhde η_p yhtälöstä:

$$\eta_p = \frac{R_r}{R_r + R_h},\tag{4.10}$$

jossa R_r on säteilyresistanssi ja R_h häviöresistanssi. /5, s. 30-37/

Kaistanleveys kuvaa käytettävää taajuusaluetta, jolla antenni säteilee ja vastaanottaa energiaa. Esimerkiksi tässä sovelluksessa kaistanleveys on 83 MHz (2400-2483,5MHz).

5 Zigbee

Zigbee tarkoittaa lyhyen kantaman tietoliikenneverkkoa. Vuonna 2003 valmistui ensimmäinen standardi (802.15.4), joka loi pohjan Zigbeelle. Zigbee on pyritty kehittämään edulliseksi ja energiaa säästäväksi, langattomaksi ohjausjärjestelmäksi. Tekniikan taustalla on ollut tarve erilaisten anturiverkkojen luominen. Tekniikan avulla voidaan yhdistää useita sensoreita sekä muita tietoa kerääviä laitteita ja lähettää tietoa langattomasti. /7/

5.1 Protokollapino

Standardi IEEE 802.15.4 määrittelee pinon alimmat kerrokset eli fyysisen ja MAC-osan (Media Access Control). Zigbee-protokolla määrittelee ylemmät kerrokset, joissa määritellään verkkojen muodostukset, tietoturva ja elementtien välinen kommunikointi (kuva 15). Sovellusten kehittäjälle jää ainoastaan ylimmän kerroksen toteuttaminen hyväksikäyttäen Applicationobjects-tason tarjoamia palveluita. /8/



Kuva 15. Zigbee-protokollapino /8, s.26/

5.2 Tekniikka yleisesti

Zigbee-laitteita on kolmea eri tyyppiä. Verkon koordinaattori NCN (Network Coordinator Node) on laite, jota on yksi verkkoa kohden. Se toimii linkkinä verkkojen välillä sekä varastoi tietoa verkon rakenteesta ja siinä olevista laitteista. Täyden toiminnan laite FFD (Full Functon Device) toimii normaalina koordinaattorina eli reitittimenä ja välittää dataa laitteiden välillä. FFD pystyy myös toimimaan verkon koordinaattorina. Kolmas laitetyyppi on rajoitetun toiminnan laite RFD (Reduced Function Device), joka pystyy lähettämään ja vastaanottamaan dataa ainoastaan koordinaattorille. Maksimoidakseen käyttöaikansa RFD pystyy menemään virransäästötilaan, jolloin se käyttää energiaa vain datan lähetyksessä. /8/

Standardi määrittelee kolme erilaista verkkotopologiaa, star-, peer to peer- ja clustertree-topologiat, jotka on esitetty kuvassa 16. Star-topologiassa FFD-laite muodostaa verkon ja toimii PAN (Personal Area Network) -koordinaattorina, muiden laitteiden kommunikoidessa tämän välityksellä. Peer to peer -topologiassa laitteet voivat kommunikoida keskenään, mutta tässäkin topologiassa on PAN-koordinaattori, joka ilmoittaa verkon olemassa olon muille laitteille. Peer to Peer -verkon etuna on se, että verkko voi olla monimutkaisempi kuin star-verkko. Cluster-tree -topologia on star- ja peer to peer -topologioiden yhdistelmä. Verkko koostuu klustereista kuvan 16 mukaisesti. /8/



Kuva 16. Star-, Peer to peer- ja Cluster-Tree-topologiat /8, s.27/

Laitteet voivat lisäksi lähettää jaksollista, keskeyttävää tai toistuvaa dataa. Jaksollinen data lähetetään määritellyn jakson mukaisesti, ja lopun aikaa laite on virransäästötilassa. Keskeyttävä data lähetetään vasta, kun määritelty keskeytys tulee eli tapahtuma tapahtuu tai jokin arvo saavuttaa jonkin rajan. Muun ajan laite on virransäästötilassa. Toistuvaa dataa lähetetään tietyllä aikavälillä, jolloin laite lähettää ja varmistaa tiedon perille saapumisen. Laite toimii jatkuvasti, menemättä virransäästötilaan. /8/

5.3 Taajuusalue ja modulaatio

Zigbee käyttää kolmea eri taajuutta. Taajuudet sijaitsevat ISM-taajuusalueella (Industrial, Scientific & Medical), 868 MHz, 915 MHz ja 2,45GHz. Tässä sovelluksessa käytetään 2,45 GHz:n taajuutta. Zigbee käyttää eri modulaatioita taajuudesta riippuen. Alemmat taajuudet käyttävät binaarista vaiheavainnusta BPSK (Binary Phase Shift Keying). Ylempi taajuus käyttää ortogonaalista nelivaiheista vaiheavainnusta O-QPSK (Orthogonal Quadrature Phase Shift Keying). /7/

BUN	PHY Frequency (MHz) (MHz)	Spreading parameters		Data parameters		
(MHz)		Chip rate (kchip/s)	Modulation	Bit rate (kb/s)	Symbol rate (ksymbol/s)	Symbols
868/915	868-868.6	300	BPSK	20	20	Binary
	902-928	600	BPSK	40	40	Binary
2450	2400-2483.5	2000	O-QPSK	250	62.5	16-ary Orthogonal

Kuva 17. Käytetyt taajuudet, modulaatiot ja nopeudet /7/

5.4 Siirtonopeus ja -matka

Zigbeen siirtonopeus on riippuvainen sekä käyttötaajuudesta että modulaatiotavasta. Siirtomatka on puolestaan riippuvainen käytetystä tehosta. Tehonkulutus on haluttu tekniikan suunnittelussa mahdollisimman pieneksi. Siksi lähetysmatkat ovat pieniä, ympäristön ja muiden tekijöiden mukaan 10 – 100 metriä. /7/

6 Mikroliuska-antenni

Mikroliuska-antenni perustuu mikroliuskatekniikalla tehtyyn resonaattoriin. Antenni on rakenteeltaan kuin kaksikerroksinen piirilevy, josta toinen puoli toimii säteilijänä ja toinen maatasona. Säteilijä on yleensä pyöreä tai suorakulmainen, kuten kuvasta 18 nähdään, ja sitä voidaan syöttää usealla eri tavalla. Tässä sovelluksessa käytetään suorakaiteen muotoista resonaattoria, jota syötetään koaksiaalisyötöllä. Mikroliuska-antennin etuja ovat pieni koko, keveys, tasomaisuus, helppo integroitavuus ja edullisuus. Suurimmat heikkoudet ovat huono hyötysuhde ja kapeakaistaisuus. /3, s. 101-106/



Kuva 18. Yleisiä mikroliuska-antennin muotoja /9/

6.1 Syöttötekniikat

Mikroliuska-antennia voidaan syöttää usealla eri tavalla. Tekniikat voidaan jakaa kahteen eri luokkaan kontakti- ja kontaktitonsyöttöön. Kontaktitekniikalla syötetään suoraan säteilijään, esimerkiksi koaksiaalisyötöllä (kuva 19) tai mikroliuskalla.



Kuva 19. Mikroliuska-antenni, jossa on koaksiaalisyöttö. /3, s.103/

Kontaktittomassa sähkömagneettisen kentän kytkeytyminen on tehty mikroliuska johdon ja säteilijän välille (kuva 20).



Kuva 20. Aukon välityksellä syötetty mikroliuska-antenni /3, s.103/

6.2 Suorakulmainen mikroliuska-antenni koaksiaalisyötöllä

Suorakulmainen mikroliuska-antenni toimii puolen aallon pituisena resonaattorina, jonka päätyjen välillä aalto heijastuu edestakaisin. Pituussuunnassa kenttä on sinimuotoinen ja leveyssuunnassa vakio. Säteily vuotaa antennin avoimista päistä.

Antennin pituus l on puoli aallonpituutta resonanssitaajuudella f_r , joka saadaan yhtälöstä:

$$l = \frac{c}{2f_r \sqrt{\varepsilon_{reff}}} - 2\Delta l_0, \tag{6.1}$$

jossa Δl_0 on avoimen pään pidennys, joka saadaan yhtälöstä (3.13). Levyn leveys vaikuttaa säteilevien magneettivirtojen pituuteen ja näin ollen myös säteilytehoon. Toisaalta mitä suurempi leveys w on, sitä enemmän väärien aaltomuotojen merkitys kasvaa. Johdon likimääräinen leveys saadaan yhtälöstä:

$$w = \frac{\lambda_0}{2\sqrt{\varepsilon_r}},\tag{6.2}$$

jossa λ_0 on aallonpituus tyhjiössä ja \mathcal{E}_r on suhteellinen permittiivisyys. Leveys w saadaan myös yhtälöstä:

$$w = \frac{\lambda_s}{2},\tag{6.3}$$

jossa λ_{g} on aallonpituus materiaalissa.

Koaksiaalijohdolla syötetyn antennin sijaiskytkentä muodostuu kahdesta rinnan kytketystä johdosta (kuva 21), jotka on päätetty admittanssilla ($G_r + jB$). Säteilykonduktanssi G_r saadaan yhtälöstä:

$$G_{r} = \begin{cases} w_{eff}^{2} / (90\lambda_{0}^{2}), kunw_{eff} < 0.35\lambda_{0} \\ w_{eff} / (120\lambda_{0}) - 1/(60\pi^{2}), kun0.35\lambda_{0} \le w_{eff} \le 2\lambda_{0} \\ w_{eff} / (120\lambda_{0}), kunw_{eff} > 2\lambda_{0}, \end{cases}$$
(6.4)

jossa w_{eff} ekvivalenttisen aaltoputken leveys yhtälöstä (3.9). Avoimen pään pidennystä vastaava suskeptanssi B saadaan yhtälöstä:



Kuva 21. Suorakulmaisen koaksiaalijohdolla syötetyn mikroliuska-antennin sijaiskytkentä. /3, s.103/

Sisäänmenoimpedanssi Z_{in} on riippuvainen syöttöpisteen paikasta (kuva 22). Z_{in} on suurimmillaan reunassa. Valitsemalla syöttöpiste keskemmältä antennia, jossa resonassijännite on pienempi, saadaan pienempi Z_{in} . /3, s. 101-106/



Kuva 22. Syötön sijoitus /5, s.247/

Siirtojohtomallin mukaan leveyssuunnalla ei ole vaikutusta sisäänmenoimpedanssiin. Kahden levyn välisen aukon säteilyresistanssille R_e on johdettu kaava:

$$R_e = \frac{2\eta}{kw} \frac{1}{1 - \frac{k^2 h^2}{24}},\tag{6.6}$$

jossa η on tyhjiön aaltoimpedanssi (376,7 Ω), k on aaltoluku ($2\pi/\lambda$), w antennin leveys ja h substraatin paksuus. Tämän avulla voidaan laskea koaksiaalijohdon kuormitusresistanssi, kun syöttöpiste siirtyy pitkin levyn akselia (Kuva 22). Levyn keskellä impedanssi on nolla. Reunoilla impedanssi on R_e . Syöttöpisteen resistanssi R saadaan laskettua kaavasta:

$$R = \frac{R_e}{2} \sin^2 \frac{\pi x}{L},\tag{6.7}$$

jossa x on etäisyys levyn keskipisteestä pitkin akselia ja L on levyn pituus. Yhtälön (6.7) avulla voidaan hakea syöttöpisteelle impedanssin kannalta sopiva paikka. /5, s. 242-248/

6.3 Ympyräpolarisaatio

Kahden polarisaation eli ympyräpolarisoiva mikroliuska-antenni voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Ympyräpolarisaatio saadaan syöttämällä neliön tai ympyrän muotoista mikroliuska-antennia kahdesta eri kohtaa niin, että syöttöpisteiden välinen vaihe-ero on 90° (kuva 23). Molemmat kohdat säteilevät lineaaripolarisoituneen kentän kohtisuoraan levyä vastaan. Jos kumpikin muoto herätetään yhtä voimakkaana ja vaihesiirrolla, saadaan ympyräpolarisaatio. /3, s. 101-106/



Kuva 23. Syöttö kahdesta eri kohtaa /3, s.106/

Vaihe-ero saadaan myös, jos ympyrän tai neliönmuotoisen antennin geometriaan aiheutetaan pieni häiriö (kuva 24). Tällöin antennin muodot erottuvat ja niiden resonanssitaajuudet poikkeavat toisistaan. Kun antennia syötettään oikeasta kohtaa ja resonanssitaajuuksien väliltä, säteily on ympyräpolarisoitunutta. /3, s. 101-106/



Kuva 24. Antenninigeometriaan on aiheutettu häiriö /3, s.106/

Ympyräpolarisaatio voidaan myös toteuttaa ellipsin tai suorakaiteen muotoisella tai viisikulmaisella antennilla (kuva 25). /3, s. 101-106/



Kuva 25. Erilaisia muotoja, joilla voidaan toteuttaa ympyräpolarisaatio. /3, s.106/

6.4 Hyötysuhde ja kaistanleveys

ja

Mikroliuska-antenni on kapeakaistainen, koska sen toiminta perustuu resonanssiin. Antennin kuormittamaton hyvyysluku Q_0 on yleensä 10-100. Ideaalitapauksessa Q_0 on yhtä suuri kuin säteilyhyvyysluku Q_r . Johdin häviöiden hyvyysluku Q_c ja dielektristen

häviöiden hyvyysluvut saadaan seuraavista yhtälöistä:

$$Q_c = h \sqrt{\mu_0 \pi f_r \sigma} = h / \delta_s \tag{6.8}$$

$$Q_d = \varepsilon_r' / \varepsilon_r'' = 1/\tan\delta, \tag{6.9}$$

joissa δ_s on tunkeutumissyvyys ja tan δ on häviötangentti. Johdin- ja dielektriset häviöt pienentävät kuormittamatonta hyvyyslukua. Säteilyhyvyysluku saadaan yhtälöstä:

$$Q_r = \frac{\omega_r W_T}{P_c},\tag{6.10}$$

jossa ω_r on kulmaresonanssitaajuus, W_T on liuskaan varastoitunut kokonaisenergia ja P_c on johdehäviöt. Kuormittamaton hyvyysluku saadaan yhdistämällä eri häviötekijät:

$$\frac{1}{Q_0} = \frac{1}{Q_r} + \frac{1}{Q_c} + \frac{1}{Q_d}.$$
(6.11)

Säteilyhyötysuhde eli säteilytehon suhde antennin koko häviötehoon saadaan yhtälöstä:

$$\eta_r = \frac{Q_0}{Q_r} = \frac{Q_r^{-1}}{Q_r^{-1} + Q_c^{-1} + Q_d^{-1}}.$$
(6.12)

Mikroliuska-antennin kaistanleveyttä rajoittava tekijä on impedanssisovitus. Antennin suhteellinen kaistanleveys, jolla seisovan aallon suhde on pienempi kuin S, saadaan yhtälöstä:

$$B = \frac{S - 1}{Q_0 \sqrt{S}}.$$
(6.13)

Suuri kaistanleveys ja säteilyhyötysuhde saavutetaan, jos suhteellinen permittiivisyys on pieni ja substraatti on pieni ja antennin leveys on suuri (suorakulmaisen antennin tapauksessa). Kaistanleveyttä voidaan kasvattaa myös toteuttamalla laajakaistainen impedanssisovituspiiri tai lisäämällä parasiittisiä elementtejä. /3, s. 101-106/

7 Antennin suunnittelu ja mittaus

Antennin suunnittelu alkoi projektille asetetusta tavoitteesta, jonka mukaan antennin resonanssitaajuuden tulisi olla 2,45 GHz. Antennityypiksi valittiin mikroliuska-antenni sen pienen koon ja helpon toteutuksen vuoksi.

7.1 Antennin suunnittelu

Ensiksi oli valittava antennin substraattimateriaali. Taulukossa 1 on vertailtu kahta eri materiaalia. FR4-materiaalin etuna on hinta ja helppo työstettävyys. Materiaalin haittapuolena dielektrisyysvakioarvon vaihtelu. RT-duroidilla on puolestaan tarkka dielektrisyysvakio, mutta sen haittapuolena on kallis hinta. Antenni päätettiin tehdä FR4-piirilevylle, koska kyseistä levyä löytyi koulun varastosta. Kyseisen levyn substraatin paksuus on 1,6 mm ja kuparoinnin paksuus 35 µm.

Taulukko 1. FR4:n ja RT-duroidin ominaisuudet [10, s.44]

		Häviövakio		
Substraatti	Dielektrisyysvakio	tanδ	Edut	Haitat
			Helppo työstää,	Dielektrisyysvakio
FR4	4,3 ± 10%	0,023	halpa	vaihtelee
RT-duroidi	2,33 ± 0,02	0,0005 / 0,0012	Helppo työstää	Kallis

7.1.1 Antennin mitoitus

Mitoitus aloitettiin laskemalla aallonpituus vapaassa tilassa yhtälöstä (2.1):

$$\lambda = \frac{c}{f},$$

jossa c on valonnopeus tyhjiössä ja f on resonanssitaajuus (2,45GHz). Näin ollen aallonpituudeksi λ saatiin 12,24 mm. Mikroliuska-antenni tehtiin FR4-levylle, jonka substraatin paksuus on 1,6 mm ja suhteellinen permittiivisyys 4,3. Edellä mainittujen mittojen perusteella laskettiin mikroliuska-antennin teoreettiset mitat. Laskuissa käytettiin staattisen tilanteen yhtälöitä, koska ne ovat tarpeeksi tarkkoja 2,45 GHz:n taajuudella.

Aluksi laskettiin mikroliuska-antennin leveys w. Oletettiin, että leveys w on puoliaaltoa eristeaineessa. Yhtälöstä (6.2) saatiin

w = 0,0295m.

Seuraavaksi laskettiin efektiivinen permittiivisyys \mathcal{E}_{reff} , kun tiedettiin w:n oletettu arvo. Yhtälöstä (3.3) saatiin

$$\varepsilon_{reff} \approx \frac{4,3+1}{2} + \frac{4,3-1}{2} \frac{1}{\sqrt{1+12*0,0016m/0,0295m}} = 3,934.$$

Kun tiedettiin aallonpituus λ ja efektiivinen permittiivisyys ε_{reff} , niin laskettiin aallon pituus materiaalissa yhtälöstä (2.2):

$$\lambda_g = \frac{0.1224m}{\sqrt{3.934}} = 0.0617m.$$

Mikroliuska-antennin todellinen leveys w saatiin yhtälöstä (6.3):

$$w = \frac{0,0617m}{2} = 0,03085m.$$

Seuraavaksi laskettiin mikroliuska-antennin pituus l. Johdon pidennys Δl_0 saatiin yhtälöstä (5.13):

$$\frac{\Delta l_0}{h} = ACE/D \rightarrow \Delta l_0 = ACEh/D = 0,0012m$$

ja lopuksi laskettiin antennin pituus l yhtälöstä (6.1):

$$l = \frac{2,98*10^8 m/s}{2*2,45*10^9 Hz\sqrt{3,934}} - 2*0,0012m = 0,0285m.$$

Mikroliuska-antennin mitoiksi saatiin 1=2,85cm ja w=3,085cm.



Kuva 26. Antennielementin lasketut mitat

Laskemalla saadut arvot ovat likimääräisiä. Perusantennista oli tarkoitus tehdä kahden polarisaation antenni, joten antennista tehtiin neliön muotoinen. Antennin pituus l määrittää antennin resonanssitaajuuden ja leveys w vaikuttaa antennin säteilytehoon. Näin ollen leveys w voidaan mitoittaa samanmittaiseksi kuin pituus l. Tämän myötä antennin lähetys teho pienenee hiukan.

Antennin syöttöpiste valittiin aluksi reunan ja keskipisteen välistä. Kahden polarisaation antennissa syöttöpisteet ovat symmetrise,t eli niiden etäisyydet ovat yhtä suuret keskipisteestä.

7.2 Antennin valmistus

Antennien valmistustavaksi valittiin syövyttäminen. Syövyttämällä saadaan tarkempaa jälkeä kuin jyrsimällä. Valmistamisella tarkoitetaan kuparoinnin muodostamista piirilevyn pinnalle, reikien poraamista ja liitimien juottamista paikoilleen.

Piirilevyn pinta on kuparin peittämä. Syövyttämällä osa kuparista pois saadaan haluttu kuvio levyn pinnalle. Syövyttäminen koostui useasta eri työvaiheesta:

- Ensimmäinen työvaihe oli piirilevyn laminointi. Piirilevy pinnoitettiin molemmin puolin laminaatilla eli fotoresistillä. Laminointi tapahtui spraysumuttimella. Sen jälkeen levy kuumennettiin uunissa $120^{\circ}C$:ssa 5 minuutin ajan.
- Laminoinnin jälkeen piirilevy valotettiin. Valotuksen tarkoitus on saada aikaan kemiallinen polymeroituminen, eli fotoresistin valoherkät polymeeriosat kovettuvat, eivätkä ne liukene kehitteeseen. Valottamisessa käytettiin apuna

filmiä, jolle antennin haluttu kuvio tulostettiin. Valotus tapahtui UV-säteilyllä, jonka aallon pituus on 365 nm. Tälle aallonpituudelle polymeerikalvo on kaikkein herkin.

- Seuraava työvaihe oli piirilevyn kehitys. Kehitys tehtiin upottamalla levy kehitteeseen, jolloin valottumattomat kohdat liukenivat. UV-säteilyn valottamat laminaatin osat pysyivät piirilevyn pinnassa, koska ne olivat kovettuneet (polymeroituminen) valotuksen aikana.
- Kehittämisen jälkeen piirilevy syövytettiin. Syövytyksessä piirilevyn pinnalta poistetaan kupari halutulta alueelta eli niistä osista, joita polymeerikalvo ei enää suojaa. Syövytys tehtiin siihen tarkoitetulla laitteella. Syövyttävänä aineena käytettiin ammoniumpersulfaatti vesiliuosta. Syövytyksen tasaisuus saatiin aikaan ruiskuttamalla liuos suuttimilla piirilevyn pinnalle.
- Viimeisenä työvaiheena oli piirilevyn huuhtelu. Huuhtelun eli strippauksen tarkoitus on poistaa piirilevyn pinnalle jäänyt fotoresistikalvo. Huuhtelu tapahtui huuhtelemalla levyä alkaliliuoksella (kaliumhydroksidissa 1-2 g/l). Kohtiin, joista kalvo poistettiin, jäi kuparit. Huuhtelun jälkeen piirilevy huuhdeltiin vielä vedessä ja kuivattiin.

Syövyttämisen jälkeen antenniin porattiin pylväsporakoneella syöttöreiät (3 mm terällä). Tämän jälkeen SMA–liitin juotettiin kiinni sekä maa/ että syöttöpuolelta. Kuvissa 27-31 näkyy perusantenni ja kahden polarisaation antenni.



Kuva 27. Perusantenni säteilypuolelta



Kuva 28. Perusantennin maataso



Kuva 29. Kahdenpolarisaation antennin säteilypuoli



Kuva 30. Kahdenpolarisaation antennin maataso

7.3 Mittaukset

Antennin sähköiset ominaisuudet mitattiin RF-piirianalysaattorilla (HP 8714ET 300kHz -3000MHz RF Netrwork Analyser) koulun radiolaboratoriossa. Laboratorio on tavallinen luokkahuone, eikä sitä ole suojattu heijastuksilta.

7.3.1 Piirianalysaattorin kalibrointi

Piirianalysaattorin kalibroinnilla pyrittiin eliminoimaan kaapeleiden ja liittimien vaikutus mittaustuloksiin. Kalibroinnissa käytettiin samoja liittimiä ja kaapelia kuin mittauksissa. Kalibroitaessa antennia ei vielä kytketty paikalleen. Ensiksi asetettiin piirianalysaattorille mittauksissa käytetty taajuusalue (2,3 -2,6 GHz) ja syöttötehoksi asetettiin 10 dBm. Piirianalysaattori kytkettiin läpäisymoodiin. Tämän jälkeen valittiin kalibrointimoodi (enhanced response), jossa kalibroidaan systeemi myös heijastuksia varten. Laite pyysi yksitellen kolme referenssipistettä Smithin kartalta: avoin pääte (open), oikosulku (short) ja sovitettu pääte (load 50Ω). Käytettiin kalibrointityökalua (HP 85033D 3,5mm Calibration kit), jossa on kyseiset päät. Kytkettiin kyseinen pää kaapeliin kiinni, kun laite pyysi, ja kuitattiin. Tämän jälkeen laite oli kalibroitu mittauksia varten.



Kuva 31. Kalibrointityökalu (HP 85033D 3,5mm Calibration kit)

7.3.2 Antennin mittaus

Antenni kytkettiin piirianalysaattoriin Sucoflex-kaapelilla, jossa on urospuolinen SMAliitin molemmissa päissä. Piirianalysaattorin ja kaapelin välille laitettiin SMA/N– muunnoskappale.



Kuva 32. Perusantenni piirianalysaattoriin kytkettynä

Kun antenni oli kytketty, valittiin piirianalysaattorin valikosta logaritminen asteikko. Asteikolta nähtiin (marker-toiminnon avulla) antennin resonanssitaajuus, 3 dB:n kaistanleveys ja paluuvaimennus resonanssitaajuudella. Antennin todellinen resonanssitaajuus pyrittiin hakemaan haarukoimalla. Tiedettiin, että resonanssitaajuus saadaan isommaksi lyhentämällä antennin pituutta ja päinvastoin. Mittauksissa ei saavutettu tavoitettua 2,45 GHz:n resonanssitaajuutta, kuten taulukosta 2 nähdään. Syynä tähän on substraatin suhteellisen permittiivisyyden vaihtelu. Tuloksista huomattiin myös, mitä pienempi on paluuvaimennus sitä suurempi on 3 dB:n kaistanleveys. Epäsovituksella voidaan siis suurentaa kaistanleveyttä.

liuska nro	pituus l [mm]	leveys w [mm]	paluuvaimennus [dB]	resonanssitaajuus [GHz]	3 dB:n kaistanleveys [MHz]
1	30	30	14,4	2,387	39
2	29,8	29,8	15,2	2,422	35
3	29,6	29,6	16,3	2,4335	31
4	29,8	29,8	19,1	2,416	23
5	29,2	29,2	22,1	2,4777	14
6	29,35	29,35	23,2	2,4668	9
7	29,25	29,25	28,5	2,4363	6
8	29,3	29,3	31,8	2,43613	5
9	29,4	29,4	21,75	2,4255	14
10	29,35	29,35	22,8	2,4279	11
11	29,4	29,4	29	2,424	5

Taulukko 2. Antennin paluuvaimennus, resonanssitaajuus ja 3 dB:n kaistanleveys

Kuvassa 33 on kuvattu paluuvaimennuksen ja kaistanleveyden välistä riippuvuutta.



Kuva 33. Paluuvaimennuksen ja kaistanleveyden riippuvuutta kuvaava kuvaaja

Antennin impedanssi oli tarkoitus sovittaa 50 ohmiin syöttöpisteen paikan valinnalla. Ensiksi tehtiin protokappale, jossa syötön paikka oli antennin keskipisteen ja reunan puolessa välissä. Tiedettiin, että reunalla impedanssi on suuri ja keskellä antennia 0 Ω . Tämän tiedon perusteella haarukoitiin syöttöpisteen arvo, kunnes päästiin tarpeeksi lähelle suunniteltua sovitusta. Syöttöpisteen sovituksen mittaustulokset ovat taulukossa 3.

Taulukko 3. Sovituksen mittaustulokset

Liuska	Syötön etäisyys	
nro	keskipisteestä[mm]	Impedanssi [Ω]
1	7,5	76
2	7	58
3	6	55,6
4	7	56,4
5	7	60,6
6	7	54
7	5	53,6
8	5,5	47,13
9	5	59
10	5	59
11	5	53

Viimeiseksi mitattiin kahden polarisaation antennin S_{21} -parametri eli siirtovahvistus portista 1 porttiin 2. Kahdenpolarisaation antenni kytkettiin piirianalysaattorin lähtöportin (reflection port) ja tuloportin (transmission port) väliin kuvan 34 mukaisesti. Kytkennässä käytettiin Sucoflex-kaapeleita, joissa on SMA-liitin molemmissa päissä.



Kuva 34. Kahden polarisaation antenni on kytketty piirianalysaattorin lähtö- ja tuloportin väliin.

Siirtovahvistusta mitattaessa lähtöportista lähetettiin 2,3-2,6 GHz taajuuskaistalla 10 dBm:n lähtötehoa ja tuloportista mitattiin syöttöjen välinen siirtovahvistus. Mittaustulokset taulukossa 4 ja mittausten kuvaajat liitteinä 1 ja 2.

Liuska nro	Siirtovahvistus [dB]
10	-29,725
11	-40,299

Taulukko 4. S_{21} -parametrin mittaustulokset

8 Yhteenveto

Työn tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa kahdenpolarisaation 2,45 GHz:n mikroliuskaantenni anturikeskuksen Zigbee-sovellukseen. Antennin resonanssitaajuutta haettaessa huomattiin, että taajuutta ei saada kohdalleen. Syynä tähän on FR4–materiaalin suhteellisen permittiivisyyden arvon vaihtelu (4,3 ±10 %). Lähimpänä suunniteltua tavoitetta oli 2,4368 GHz:n resonanssitaajuus. Mittaustuloksista voidaan todeta, että substraattimateriaalin tulisi olla tarkempaa, esimerkiksi RT-duroidia, jolla on tarkempi suhteellisen permittiivisyyden arvo (2,33 ± 0,02). Näin ollen voitaisiin valmistaa 2,45 GHz:n antenni.

Sovitettaessa antennia saavutettiin liki 50 Ω:n sovitus, kuten taulukon 3 tuloksista nähdään. Sovituksesta olisi saanut tarkemman, jos syöttöreiästä olisi tehnyt pienemmän kuin 3 mm. Samalla mittaustuloksista huomattiin, että mitä parempi sovitus sitä kapeampi on kaistanleveys. Epäsovituksella saavutetaan siis suurempi kaistanleveys. Myös pienentämällä substraatin suhteellisen permittiivisyyden arvoa saavutetaan leveämpi kaistanleveys. Antenni on valmistettava joko eri substraattimateriaalista tai tekemällä substraatin ja säteilijän väliin ilmavälin kuvan 35 mukaisesti.



Kuva 35 Säteilijän ja substraatin väliin on tehty ilmaväli

Lähteet

/1/	Electrian kotisivut. < <u>http://electria.metropolia.fi/index.php?id=105</u> >.				
	Luettu 18.4.2009.				
/2/	Lehto, Arto & Räsänen, Antti: Radioaaltojen maailma. Helsinki: Otatieto				
	Oy, 2006.				
/3/	Lehto, Arto & Räsänen, Antti: Rf- ja mikroaaltotekniikka. Helsinki:				
	Otatieto Oy, 1994.				
/4/	Lehto, Arto & Räsänen, Antti: Radiotekniikan perusteet. Helsinki: Otatieto				
	Oy, 2007.				
/5/	Lindell, Ismo & Nikoskinen, Keijo: Antenniteoria. Espoo: Otatieto Oy,				
	1995.				
/6/	Florida State Universityn kotisivut.				
	< http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd-04102004-				
	<u>143656/unrestricted/Chapter2.pdf</u> >. Luettu 28.3.2009.				
7	Markus Sjöblomin Zigbee-dokumentti.				
	< <u>http://users.tkk.fi/virranko/sensor_networks/sjoblom1.pdf</u> >. Luettu				
	23.3.2009.				
/8/	Kuorilehto, Kohvakka, Suhonen, Hämäläinen, Hännikäinen, Hämäläinen.				
	Ultra-Low Energy Wireless Sensor Networks in Practice. Tampere,2007.				
10.1					
/9/	Florida State Universityn kotisivut.				
	< <u>nttp://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd-04102004-</u>				
	<u>143656/unrestricted/Chapter3.pdf</u> >. Luettu 28.3.2009.				

 /10/ Sanna, Juhani: 5,8 GHZ:in mikroliuska-antennien suunnittelu ja toteutus kahdeksanelementtiseen antenniryhmään. Insinöörityö. EVTEKammattikorkeakoulu, elektroniikan koulutusohjelma, 2003.







Liite 2: Siirtovahvistuksen mittaus 2